

关键指标

- RF/LO 频段：24~40GHz
- IF 频段：DC~10
- 变频损耗：8.5dB
- 本振功率：13dBm
- 芯片尺寸：0.61mmX0.92mmX0.1mm

典型应用

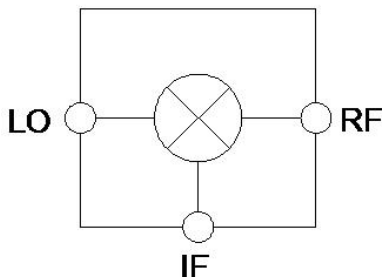
- 电子对抗
- 雷达
- 卫星通讯
- 测试测量

产品简介

XT3512 是一种通用型双平衡混频器。该芯片采用 GaAs 工艺中制造，无须外部元件或匹配电路。该装置既可作为上变频器又可用于下变频器。

该芯片有全表面钝化保护提高可靠性。

功能框图



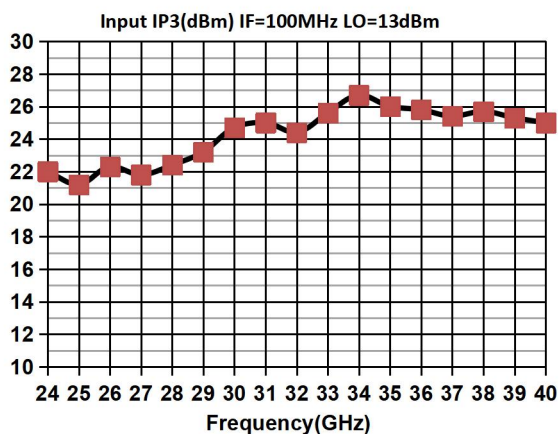
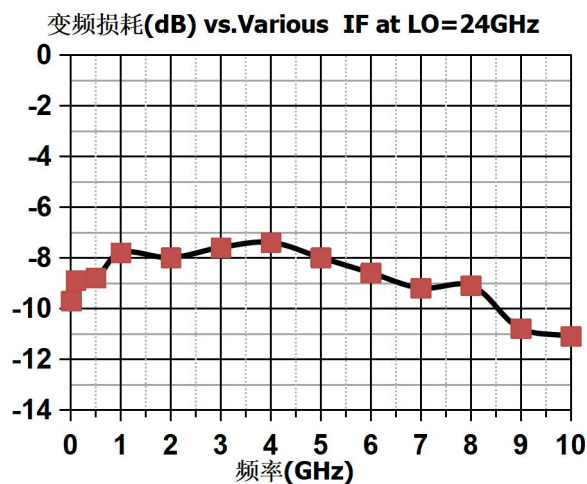
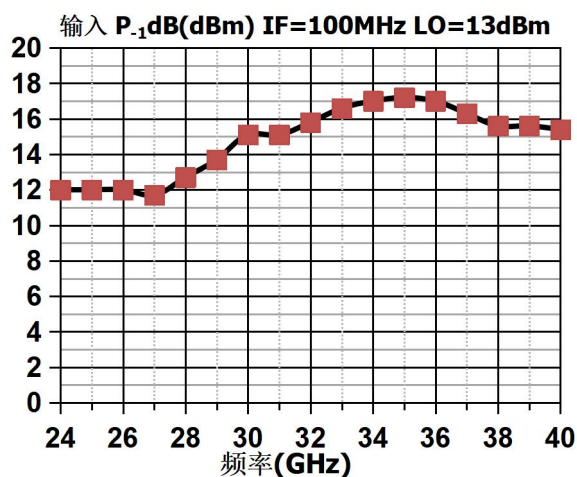
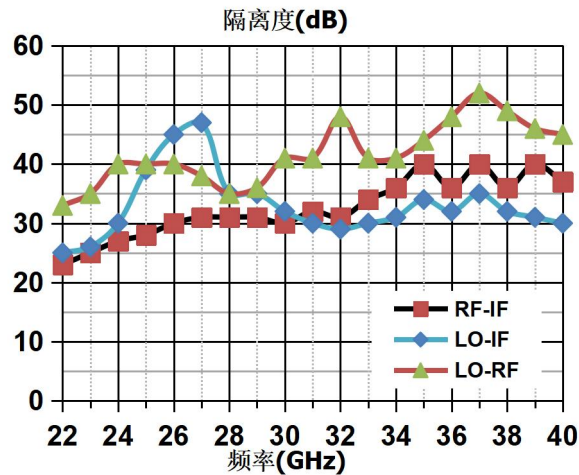
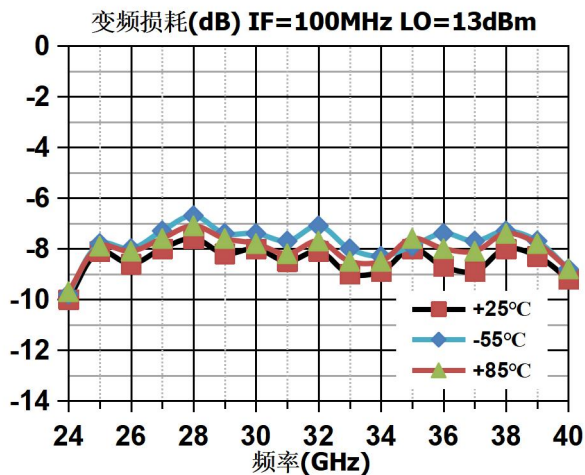
电性能 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, LO=13dBm)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频频率/本振频率	24~40			GHz
中频频率	DC~10			GHz
变频损耗	—	-8.5	-12	dB
中频端回波损耗	—	-8	—	dB
射频端回波损耗	—	-10	—	dB
本振端回波损耗	—	-10	—	dB
本振-射频隔离度	-25	-40	—	dB
本振-中频隔离度	-20	-30	—	dB
射频-中频隔离度	-20	-30	—	dB
输入 $P_{1\text{dB}}$	10	15	—	dBm

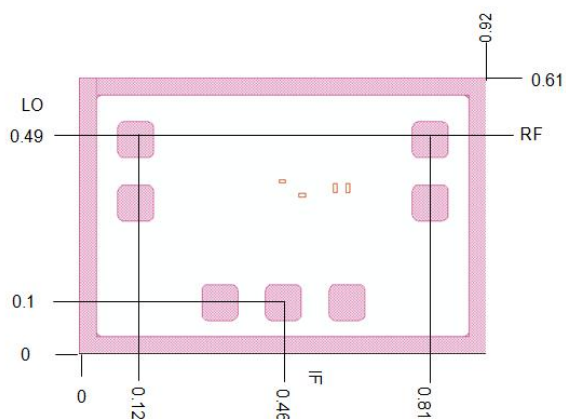
绝对最大额定值

射频/中频最大输入功率	20dBm	工作温度	-55℃~+85℃
本振最大输入功率	20dBm	存储温度	-65℃~+150℃

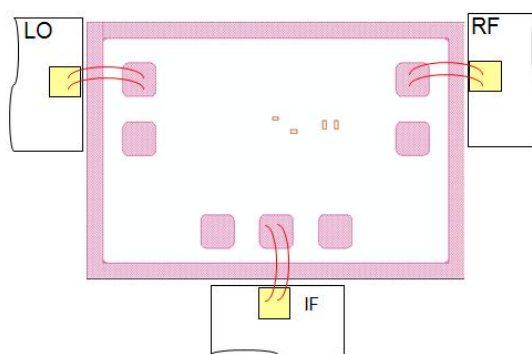
典型测试曲线



外形和端口尺寸
(以 mm 为单位)



推荐装配图



注意事项

砷化镓 MMIC 器件易受静电放电损伤。在运输、装配和试验过程中应采取防范措施。